

Silicon Diode

BY228/13

1000V / 3A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BY 228/13 · BY 228/15

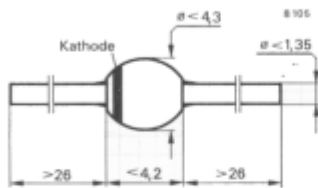
Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Hochspannungsgleichrichter

Besondere Merkmale:

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse

Abmessungen in mm



Sinterglasgehäuse
SOD 64
Gewicht max. 1,0 g

Bestempfung: Klartext

Absolute Grenzdaten

		BY 228/13	BY 228/15	
Stoßsperrspannung	U_{RSM}	1300	1500	V
Sperrspannung	U_R	1000	1200	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	50		A
Durchlaßstrom, Mittelwert	I_{FAV}	3		A
Sperrschichttemperatur	T_j	140		°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65 ... + 175		°C

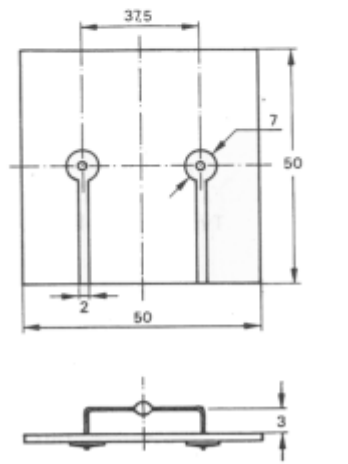
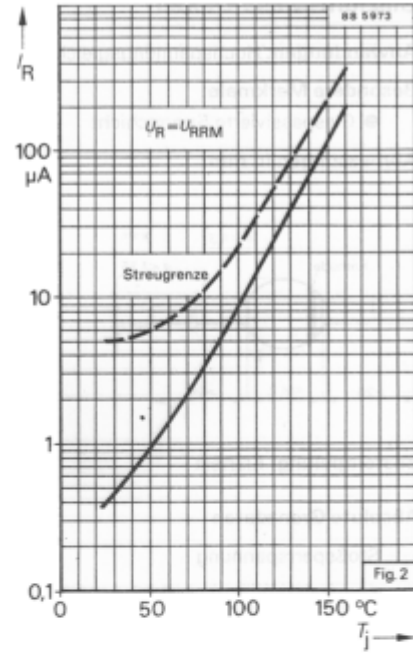
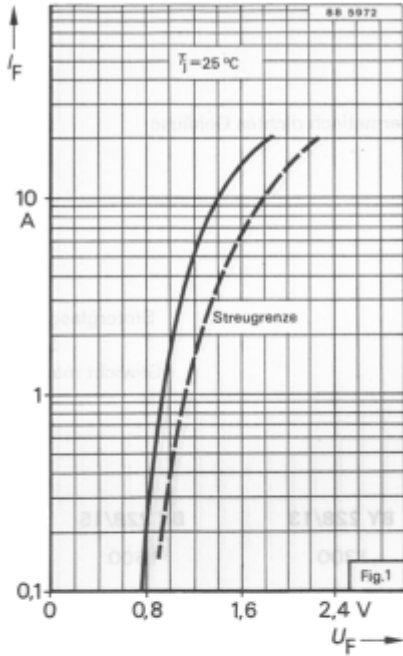
Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm	R_{thJA}	70		K/W
---	------------	----	--	-----

Kenngößen

		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 5 \text{ A}$	U_F			1,5	V
Sperrstrom $U_R = 1000 \text{ V}$	BY 228/13 I_R		2	5	μA
	BY 228/15 I_R		2	5	μA
$T_j = 140 \text{ °C}$, $U_R = 1000 \text{ V}$	BY 228/13 I_R			140	μA
	BY 228/15 I_R			140	μA
Gesamte Rückwärtserholzeit $I_F = 1 \text{ A}$, $\frac{-d_i}{d_t} = 0,05 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_{rr}			20	μs

BY 228/13 · BY 228/15



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1.5 mm
 $R_{thJA} \leq 70 \text{ K/W}$

Fig. 3

88 2 5 76

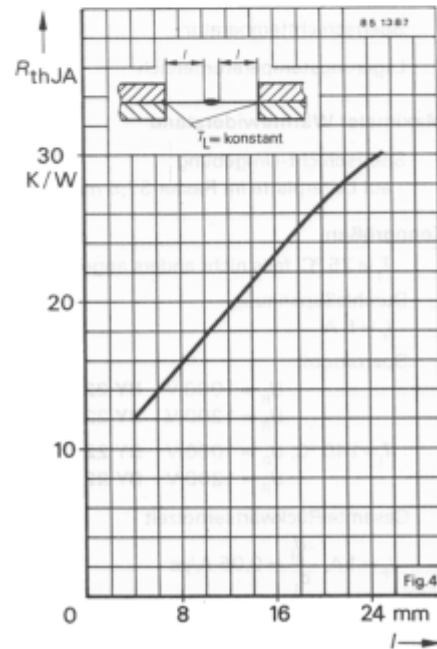


Fig. 4